Влияние структурно-нарушенного поверхностного слоя гексагонального кристалла на дисперсию и затухание поверхностных акустических волн Рэлея

© В.В. Косачёв, Ю.Н. Гандурин

Московский инженерно-физический институт (Государственный университет), 115409 Москва, Россия

E-mail: kosachev@theor.mephi.ru

(Поступила в Редакцию 14 июня 2007 г.)

С учетом тонкого (по сравнению с длиной поверхностной волны) нарушенного изотропного поверхностного слоя, граничащего с вакуумом и расположенного на поверхности гексагонального кристалла с осью симметрии шестого порядка перпендикулярной поверхности, получены в аналитическом виде дисперсия фазовой скорости и обратная длина затухания поверхностных акустических волн Рэлея. Показано, что в пределе длинных (по сравнению с характерным размером неоднородности) волн, представляющем наибольший интерес для экспериментаторов, изменение дисперсии фазовой скорости волн Рэлея пропорционально второй, а обратная длина затухания — пятой степени частоты. Численно рассчитана обратная длина затухания рэлеевской волны. В настоящей работе ранее предложенный одним из авторов (В.В. Косачев, 1998) метод расчета обобщается на случай изотропного нарушенного слоя на анизотропной (гексагональной) подложке.

PACS: 43.20.Jr, 43.20.Hq, 43.20.Fn

1. Введение

При полировании оптических поверхностей диэлектрических материалов наряду с шероховатостью поверхности возникает так называемый структурно-нарушенный поверхностный слой, который оказывает существенное влияние на акустические свойства материала.

Влияние шероховатости поверхности на распространение поверхностных акустических волн (ПАВ) было рассмотрено в литературе достаточно подробно [1–7]. В настоящей работе структурно-нарушенный слой рассматривается без учета шероховатости.

Одним из возможных методов исследования параметров нарушенного слоя являются ПАВ. В основе исследования структурно-нарушенного слоя с помощью ПАВ лежит утверждение, что упругие свойства среды (плостноть и коэффициенты Ламэ) изменяются при наличии различных структурных дефектов, что в свою очередь влияет на характер распространения ПАВ по нарушенному слою. Так, при исследовании поверхности металлов с помощью рэлеевских волн последние используются как средство неразрушающего контроля, позволяющего определять дефекты, степень и глубину термической закалки, остаточные механические напряжения и качество механической обработки поверхности [8].

Актуальной является также задача определения структуры существующего в металлах неоднородного приграничного слоя, свойства которого отличны от объемных характеристик [9,10]. В работах [11,12] изучалось влияние приграничных неоднородностей на характеристики волн Рэлея в коротковолновом пределе (длина волны много меньше характерных размеров дефекта). В работе [13] проведено измерение коэффициента затухания рэлеевской волны из-за рассеяния на неоднородностях нарушенного слоя при различных способах обработки образцов.

В работах [14,15] решается обратная задача: исследование структуры неоднородного поверхностного слоя изотропного материала по дисперсии фазовой скорости волн Рэлея. Рассмотрены флуктуации коэффициентов Ламэ и плотности массы, которые считаются зависящими только от глубины нарушенного слоя.

Иной подход продемонстрирован в работах [16–18], где исследовались влияние индивидуальных свойств структурных дефектов (вакансионная пора, дислокация, микротрещина) и геометрия их расположения относительно поверхности на процесс рассеяния ПАВ Рэлея. Например, в работе [16] на основе вариационного метода рассмотрена задача рассеяния ПАВ Рэлея на пограничных дефектах. Получены коэффициенты отражения и прохождения для случая прямоугольной полости, которая может располагаться как вблизи поверхности, так и на глубине. В работе [17] приведены результаты экспериментальных исследований рассеяния рэлеевских волн двумерной выемкой, сформированной на поверхности алюминиевого образца. Для широкого диапазона значений глубины выемки выполнен полный комплекс измерений параметров рассеянных полей — угловых характеристик рассеянных продольных и сдвиговых объемных волн, а также коэффициентов отражения и прохождения поверхностных волн Рэлея. В работе [18] исследовалась зависимость дислокационного поглощения ПАВ Рэлея от глубины залегания дислокации для наиболее простого случая статических дислокаций, параллельных поверхности. Рассматривались случаи винтовой дислокации у поверхности полубесконечного образца и краевой дислокации, размещенной параллельно поверхности тела. Отдельно получен вклад от полевого затухания ПАВ Рэлея, а также от затухания на ядрах дислокации.

В работах [19–21] найдено дисперсионное соотношение волн Рэлея. В частности, в работе [19] получено дисперсионное соотношение рэлеевских волн в коротковолновой области для стекол со слабым экспоненциальным изменением модулей упругости и плотности в приграничном слое, созданном механической обработкой или методом ионной имплантации. В [20] получена дисперсия фазовой скорости ПАВ Рэлея в длинноволновом пределе для изотропной среды с произвольным типом приповерхностной неоднородности, зависящей только от глубины. В [21] изучалось влияние приграничных неоднородностей на характеристики волн Рэлея в коротковолновом пределе. Считалось, что характеристики слоя зависят только от глубины. Получена дисперсия фазовой скорости и коэффициент затухания.

В работах [22,23] используется подход теории рассеяния для нахождения коэффициента затухания волны Рэлея. Так, в [22] рассмотрено рассеяние волны Рэлея поверхностной неоднородностью плотности массы изотропного твердого тела. Считается, что плотность массы зависит от глубины экспоненциально. В [23] предполагалось, что флуктуации плотности и коэффициентов Ламэ вносят вклад в затухание независимо и также имеют экспоненциальную зависимость от глубины.

Таким образом, анализ приведенной литературы показывает, что существует два подхода для исследования приповерхностного нарушенного слоя.

1) Метод функции Грина [22,23], дающий возможность найти только длину затухания поверхностной волны. При этом в [22] учитывается лишь флуктуация плотности, в то время как в [23] рассматривается еще и флуктуация коэффициентов Ламэ. Однако в обеих работах предполагается, что зависимость характеристик слоя от глубины задается экспонентой, т. е. она детерминирована.

2) Метод среднего поля [19–21], позволяющий найти не только длину затухания, но и дисперсию фазовой скорости. Однако плотность и модули упругости в этих работах считаются зависящими только от глубины, и флуктуации этих параметров не рассматриваются.

В отличие от [19–23] в [24] с помощью модифицированного метода среднего поля [7] найдена дисперсии фазовой скорости и обратная длина затухания волн Рэлея для тонкого изотропного нарушенного слоя на изотропной подложке. Учитывались в произвольной форме как флуктуации плотности, так и флуктуации коэффициентов Ламэ.

Во всех цитированных работах рассматривается только изотропное твердое тело. В настоящей работе метод, предложенный в [24], обобщается на случай анизотропной (гексагональной) подложки.

2. Постановка задачи. Эффективные граничные условия

Пусть на поверхности полубесконечного гексагонального кристалла расположен изотропный слой толщины *d*, граничащий с вакуумом. Кристалл характеризуется плотностью массы $\rho^{(0)}$ и тензором модулей упругости $C_{\alpha\beta\mu\nu}^{(0)}$, а слой — соответственно $\rho^{(1)}(\mathbf{x})$ и $C_{\alpha\beta\mu\nu}^{(1)}(\mathbf{x})$. Предполагается, что ось симметрии шестого порядка гексагонального кристалла направлена перпендикулярно поверхности. Кристалл занимает полупространство $x_3 > 0$. Будем считать, что толщина слоя мала по сравнению с длинной рэлеевской волны $d \ll \lambda$. Требуется найти дисперсию фазовой скорости и обратную длину затухания.

Для гармонической волны зависимость поля смещения от времени представляется в виде $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{u}(\mathbf{x} \mid \omega)$ × $\exp(-i\omega t)$, тогда уравнения движения имеют вид

$$\begin{cases} L_{a\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega) u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega) = 0, & -d < x_{3} < 0, \\ L_{a\mu}^{(0)}(\mathbf{x} \mid \omega) u_{\mu}^{(0)}(\mathbf{x} \mid \omega) = 0, & 0 < x_{3} < +\infty, \end{cases}$$
(1)

где

(1)

$$L_{\alpha\mu}(\mathbf{x} \mid \omega) = \rho(\mathbf{x})\omega^2 \delta_{\alpha\mu} + \frac{\partial}{\partial x_{\beta}} C_{\alpha\beta\mu\nu}(\mathbf{x}) \frac{\partial}{\partial x_{\nu}}$$

(1)

Граничные условия можно записать как

$$C^{(1)}_{\alpha 3\mu\nu}(\mathbf{x}) \frac{\partial u^{(1)}_{\mu}}{\partial x_{\nu}} \bigg|_{x_{3}=-d} = \mathbf{0},$$

$$C^{(0)}_{\alpha 3\mu\nu}(\mathbf{x}) \frac{\partial u^{(0)}_{\mu}}{\partial x_{\nu}} \bigg|_{x_{3}=0} = C^{(1)}_{\alpha 3\mu\nu}(\mathbf{x}) \frac{\partial u^{(1)}_{\mu}}{\partial x_{\nu}} \bigg|_{x_{3}=0},$$

$$\lim_{x_{3}\to+\infty} u^{(0)}_{\alpha}(\mathbf{x} \mid \omega) = \mathbf{0}.$$
(2)

Так как $d \ll \lambda$, разложим граничное условие на поверхности в окрестности $x_3 = 0$ — до членов второго порядка малости

$$C_{\alpha 3 \mu \nu}^{(1)}(\mathbf{x}) \frac{\partial u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega)}{\partial x_{\nu}} \Big|_{x_{3}=0-}$$

$$= d \frac{\partial}{\partial x_{3}} \left(C_{\alpha 3 \mu \nu}^{(1)}(\mathbf{x}) \frac{\partial u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega)}{\partial x_{\nu}} \right) \Big|_{x_{3}=0-}$$

$$- \frac{d^{2}}{2} \frac{\partial^{2}}{\partial x_{3}^{2}} \left(C_{\alpha 3 \mu \nu}^{(1)}(\mathbf{x}) \frac{\partial u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega)}{\partial x_{\nu}} \right) \Big|_{x_{3}=0-} + O(d^{3}). \quad (3)$$

Далее исключим из правой части (3) производные по x_3 . Для этого левую часть (3) можно переписать в виде

$$\frac{\partial u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega)}{\partial x_{3}} \bigg|_{x_{3}=0-} = -\Gamma_{\mu\lambda}^{(1)-1}(\mathbf{x})C_{\lambda3\mu\Delta}^{(1)}(\mathbf{x}) \times \frac{\partial u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega)}{\partial x_{\Delta}} \bigg|_{x_{3}=0-} + O(d), \quad (4)$$

где $\Gamma_{\alpha\mu}^{(1)}(\mathbf{x}) = C_{\alpha3\mu3}^{(1)}(\mathbf{x})$. Здесь и далее индексы ϕ, Δ, θ пробегают значения 1 и 2. В первом слагаемом в правой части (3) подставим вторую производную по x_3 из уравнения движения, а первую — из (4). В результате

получим эффективное граничное условие на поверхности $x_3 = 0$ в первом порядке по *d*

$$C_{\alpha 3 \mu \nu}^{(1)}(\mathbf{x}) \left. \frac{\partial u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega)}{\partial x_{\nu}} \right|_{x_{3}=0-} = -d\omega^{2} \rho^{(1)}(\mathbf{x}) u_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega) \Big|_{x_{3}=0-} - d \left. \frac{\partial}{\partial x_{\phi}} \tilde{C}_{\alpha \phi \mu \Delta}^{(1)}(\mathbf{x}) \left. \frac{\partial u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega)}{\partial x_{\Delta}} \right|_{x_{3}=0-} + O(d^{2}),$$
(5)

где $\tilde{C}^{(1)}_{\alpha\phi\mu\Delta}(\mathbf{x}) = C^{(1)}_{\alpha\phi\mu\Delta}(\mathbf{x}) - C^{(1)}_{\alpha\phi\gamma3}(\mathbf{x})\Gamma^{(1)-1}_{\gamma\lambda}(\mathbf{x})C^{(1)}_{\lambda3\mu\Delta}(\mathbf{x}).$

Далее, подставляя в (3) вторую производную по x_3 из уравнения движения, а первую — из (5), получаем эффективные граничные условия на поверхности $x_3 = 0$ — во втором порядке

$$C_{\alpha 3 \mu \nu}^{(1)}(\mathbf{x}) \frac{\partial u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x}|\omega)}{\partial x_{\nu}} \bigg|_{x_{3}=0-} = -dM_{\alpha \mu}^{(1)}(\mathbf{x}|\omega)u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x}|\omega) \bigg|_{x_{3}=0-} + \frac{d^{2}}{2} N_{\alpha \mu}^{(1)}(\mathbf{x}|\omega)u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x}|\omega) \bigg|_{x_{3}=0-} + O(d^{3}),$$
(6)

где

$$N_{\alpha\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega) = \frac{\partial M_{\alpha\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega)}{\partial x_3} + \frac{\partial}{\partial x_{\phi}} C_{\alpha\phi\gamma3}^{(1)}(\mathbf{x}) \Gamma_{\gamma\lambda}^{(1)-1}(\mathbf{x})$$
$$\times M_{\lambda\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega) - M_{\alpha\gamma}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega) \Gamma_{\gamma\lambda}^{(1)-1}(\mathbf{x}) C_{\lambda3\mu\phi}^{(1)}(\mathbf{x}) \frac{\partial}{\partial x_{\phi}},$$
$$M_{\alpha\mu}^{(1)}(\mathbf{x} \mid \omega) = \rho^{(1)}(\mathbf{x}) \omega^2 \delta_{\alpha\mu} + \frac{\partial}{\partial x_{\phi}} \tilde{C}_{\alpha\phi\mu\theta}^{(1)}(\mathbf{x}) \frac{\partial}{\partial x_{\theta}}.$$

Заметим, что условия (6) получены для кристалла произвольной симметрии.

3. Система уравнений для среднего поля ПАВ

Введем функцию Грина для гексагонального кристалла

$$\begin{cases} L_{\alpha\mu}(\mathbf{x} \mid \omega) D_{\mu\beta}(\mathbf{x}, \mathbf{x}' \mid \omega) = \delta_{\alpha\beta} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \\ C^{(0)}_{\alpha 3 \mu \nu} \frac{\partial D_{\mu\beta}(\mathbf{x}, \mathbf{x}' \mid \omega)}{\partial x_{\nu}} \Big|_{x_{3}=0} = 0, \\ D_{\mu\beta}(\mathbf{x}, \mathbf{x}' \mid \omega) \Big|_{|\mathbf{x}|, |\mathbf{x}'| \to \infty} \to 0. \end{cases}$$
(7)

Пользуясь интегральной теоремой Грина, можно написать

$$\int_{V} (u_{\alpha} L_{\alpha\mu} \omega_{\mu} - \omega_{\alpha} L_{\alpha\mu} u_{\mu}) d^{3}x$$
$$= \int_{S} dS \, \hat{n}_{\beta} C^{(0)}_{\alpha\beta\mu\nu} \left(u_{\alpha} \frac{\partial}{\partial x_{\nu}} \, \omega_{\mu} - \omega_{\alpha} \, \frac{\partial}{\partial x_{\nu}} \, u_{\mu} \right), \quad (8)$$

где \hat{n}_{β} — единичный вектор нормали к поверхности интегрирования, а **u** и ω — произвольные функции.

Выбирая их в виде $u_{\alpha} = D_{\alpha\gamma}(\mathbf{x}, \mathbf{x}'|\omega), \ \omega_{\alpha} = D_{\alpha\beta}(\mathbf{x}, \mathbf{x}''|\omega),$ получим из (8) выражение

$$D_{\beta\gamma}(\mathbf{x}'',\mathbf{x}'\,|\,\omega) = D_{\gamma\beta}(\mathbf{x}',\mathbf{x}''\,|\,\omega). \tag{9}$$

Подставляя в (8) $u_{\alpha} = u_{\alpha}(\mathbf{x} \mid \omega), \ \omega_{\alpha} = D_{\alpha\gamma}(\mathbf{x}, \mathbf{x}' \mid \omega),$ получим систему уравнений движения

$$u_{\gamma}^{(0)}(\mathbf{x}' \mid \omega)\theta(x'_{3}) = \int d^{2}x_{\parallel} \Big(D_{\alpha\gamma}(\mathbf{x}, \mathbf{x}' \mid \omega) C_{\alpha3\mu\nu}^{(0)} \frac{\partial}{\partial x_{\nu}} u_{\mu}^{(0)}(\mathbf{x} \mid \omega) \Big) \Big|_{x_{3}=0+},$$
(10)

где $\theta(x)$ — ступенчатая функция Хевисайда, а $\mathbf{x}_{||} = (x_1, x_2, \mathbf{0}).$

Рассмотрим (10) на поверхности $x'_3 = 0$. Используя равенство $\mathbf{u}^{(0)}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) = \mathbf{u}^{(1)}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega)$, граничное условие (2) и свойство (9), получаем

$$u_{\gamma}^{(1)}(\mathbf{x}_{\parallel}' \mid \omega) = \int d^{2}x_{\parallel} D_{\gamma\alpha}(\mathbf{x}_{\parallel}', \mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) C_{\alpha 3 \mu \nu}^{(1)}(\mathbf{x}_{\parallel}) \frac{\partial}{\partial x_{\nu}} u_{\mu}^{(1)}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega), \quad (11)$$

где под интегралом в правой части стоит эффективное граничное условие (6).

Далее произведем усреднение по всевозможным реализациям характеристик тонкого слоя. Для этого введем оператор \hat{P} , усредняющий все величины, и оператор $\hat{Q} = 1 - \hat{P}$. Любую функцию можно представить в виде $f = \hat{P}f + \hat{Q}f$. Очевидно также, что \hat{P} и \hat{Q} коммутируют, их квадраты равны им самим и среднее значение единицы $\hat{P}1 = 1$. Пользуясь этими свойствами, а также тем, что (11) можно записать в виде

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}') = \mathbf{L}(\mathbf{x}', \mathbf{x}) \, \mathbf{u}(\mathbf{x}),\tag{12}$$

где $\mathbf{L}(\mathbf{x}', \mathbf{x}) = d\mathbf{L}_1(\mathbf{x}', \mathbf{x}) + d^2\mathbf{L}_2(\mathbf{x}', \mathbf{x}) + O(d^3)$, а d — малый параметр, с точностью до квадратичных членов по d получаем

$$\langle u_{\gamma}(\mathbf{x}_{\parallel}' \mid \omega) \rangle = \int d^{2}x_{\parallel} D_{\gamma\alpha}(\mathbf{x}_{\parallel}', \mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) \left(-d \langle M_{\alpha\mu}^{(1)}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) \rangle \right) + \frac{d^{2}}{2} \langle N_{\alpha\mu}^{(1)}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) \rangle \right) \langle u_{\mu}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) \rangle + d^{2} \int d^{2}y_{\parallel} d^{2}x_{\parallel} \times D_{\gamma\beta}(\mathbf{x}_{\parallel}', \mathbf{y}_{\parallel} \mid \omega) \left(\langle M_{\beta\delta}^{(1)}(\mathbf{y}_{\parallel} \mid \omega) D_{\delta\alpha}(\mathbf{y}_{\parallel}, \mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) M_{\alpha\mu}^{(1)}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) \rangle \right) - \langle M_{\beta\delta}^{(1)}(\mathbf{y}_{\parallel} \mid \omega) \rangle D_{\delta\alpha}(\mathbf{y}_{\parallel}, \mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) \langle M_{\alpha\mu}^{(1)}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) \rangle \left(u_{\mu}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) \right).$$
(13)

Здесь введено обозначение $\hat{P}f = \langle f \rangle$.

Для вычисления средних значений операторов введем следующие обозначения:

$$\rho^{(1)}(\mathbf{x}_{\parallel}) = \rho_0 \big(1 + f_1(\mathbf{x}_{\parallel}) \big),$$

$$\lambda(\mathbf{x}_{\parallel}) = \lambda_0 \big(1 + f_2(\mathbf{x}_{\parallel}) \big),$$

$$\mu(\mathbf{x}_{\parallel}) = \mu_0 \big(1 + f_3(\mathbf{x}_{\parallel}) \big).$$
(14)

При этом будем считать, что

$$\langle f_{i}(\mathbf{x}_{\parallel})\rangle = \mathbf{0},$$

$$\langle f_{i}(\mathbf{x}_{\parallel})f_{j}(\mathbf{x}_{\parallel}')\rangle = \varepsilon_{ij}W_{ij}(|\mathbf{x}_{\parallel} - \mathbf{x}_{\parallel}'|),$$

$$W_{ij}(\mathbf{0}) = 1, \quad \varepsilon_{ij} \ll 1,$$
 (15)

Предполагаем также, что тонкий слой слабо неоднороден:

$$f_{\alpha}(\mathbf{x}_{\parallel}) \ll 1, \quad \alpha = 1, 2, 3. \tag{16}$$

Перейдем к Фурье-представлению

$$D_{\alpha\beta}(\mathbf{x}_{\parallel}, \mathbf{x}_{\parallel}' \mid \omega) = \int \frac{d^{2}k}{(2\pi)^{2}} \exp(i\mathbf{k}(\mathbf{x}_{\parallel} - \mathbf{x}_{\parallel}')) D_{\alpha\beta}(\mathbf{k} \mid \omega),$$
$$u_{\alpha}(\mathbf{x}_{\parallel} \mid \omega) = \int \frac{d^{2}k}{(2\pi)^{2}} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{x}_{\parallel}) u_{\alpha}(\mathbf{k} \mid \omega),$$
$$W_{ij}(|\mathbf{x}_{\parallel} - \mathbf{y}_{\parallel}|) = \int \frac{d^{2}k}{(2\pi)^{2}} \exp(i\mathbf{k}(\mathbf{x}_{\parallel} - \mathbf{y}_{\parallel})) g_{ij}(|\mathbf{k}|),$$
$$\delta(\mathbf{x}_{\parallel}) = \int \frac{d^{2}k}{(2\pi)^{2}} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{x}_{\parallel}), \qquad (17)$$

$$\langle f_i(\mathbf{k})f_j(\mathbf{q})\rangle = \varepsilon_{ij}g(|\mathbf{k}|)(2\pi)^2\delta(\mathbf{k}+\mathbf{q}),$$
 (18)

где a_{ij} — корреляционный радиус неоднородности слоя,

$$\mathbf{k} = (k_1, k_2, 0), \quad \mathbf{q} = (q_1, q_2, 0),$$
 (19)

а $g(|\mathbf{k}|)$ — поверхностный структурный фактор, который выбираем в гауссовом виде

$$g(|\mathbf{k}|) = \pi a_{ij}^2 \exp\left(-\frac{\mathbf{k}^2 a_{ij}^2}{4}\right).$$
(20)

Тогда (13) принимает вид

$$\langle u_{\gamma}(\mathbf{k} \mid \omega) \rangle = \left(D_{\gamma \alpha}(\mathbf{k} \mid \omega) A_{\alpha \mu}(\mathbf{k} \mid \omega) + d^{2} D_{\gamma \beta}(\mathbf{k} \mid \omega) \right. \\ \times \int \frac{d^{2} q}{(2\pi)^{2}} B_{\beta \delta \alpha \mu}(\mathbf{q}, \mathbf{k}, \mathbf{k} - \mathbf{q} \mid \omega) D_{\delta \alpha}(\mathbf{q} \mid \omega) \right) \langle u_{\mu}(\mathbf{k} \mid \omega) \rangle,$$

$$(21)$$

где $A_{\alpha\mu}(\mathbf{k} \mid \omega)$ и $B_{\beta\delta\alpha\mu}(\mathbf{q}, \mathbf{k}, \mathbf{k} - \mathbf{q} \mid \omega)$ приведены в Приложении.

Для упрощения выражений переходим от функций $D_{\alpha\beta}(\mathbf{k} \mid \omega)$ к функциям $d_{\alpha\beta}(k \mid \omega)$.

Для этого введем матрицу поворота

$$S(\hat{\mathbf{k}}) = \begin{pmatrix} \hat{k}_1 & \hat{k}_2 & 0\\ -\hat{k}_2 & \hat{k}_1 & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{где} \quad \hat{k}_{\phi} = \frac{k_{\phi}}{k}, \qquad (22)$$

и следующие обозначения:

$$F_{\alpha}(\mathbf{k} \mid \omega) = S_{\alpha\mu}(\hat{\mathbf{k}}) \langle u_{\mu}(\mathbf{k} \mid \omega) \rangle,$$

$$d_{\alpha\beta}(k \mid \omega) = S_{\alpha\mu}(\hat{\mathbf{k}}) D_{\mu\nu}(\mathbf{k} \mid \omega) S_{\nu\beta}^{-1}(\hat{\mathbf{k}}),$$

$$T_{\alpha\beta}^{(i)}(\mathbf{k}, \mathbf{q} \mid \omega) = S_{\alpha\mu}(\hat{\mathbf{k}}) N_{\mu\delta}^{(i)}(\mathbf{k}, \mathbf{q} \mid \omega) S_{\delta\beta}^{-1}(\hat{\mathbf{q}}) = T_{\beta\alpha}^{(i)}(\mathbf{q}, \mathbf{k} \mid \omega),$$

$$t_{\alpha\beta}(\mathbf{k} \mid \omega) = S_{\alpha\mu}(\hat{\mathbf{k}}) A_{\mu\delta}(\mathbf{k} \mid \omega) S_{\delta\beta}^{-1}(\hat{\mathbf{k}}).$$
 (23)

После сделанных преобразований в (21) пробное интегрирование по углам показывает, что компоненты F_1 и F_3 отделяются от F_2 :

$$F_{2}(\mathbf{k} | \omega) = \left(d_{22}(k | \omega) t_{22}(\mathbf{k} | \omega) + d^{2} \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij} \int \frac{d^{2}q}{(2\pi)^{2}} g_{ij}(|\mathbf{k} - \mathbf{q}|) K_{22}^{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{q} | \omega) \right) F_{2}(\mathbf{k} | \omega),$$

$$(24)$$

$$\begin{pmatrix} F_{1}(\mathbf{k} | \omega) \\ F_{3}(\mathbf{k} | \omega) \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} d_{11}t_{11} + d_{13}t_{31} & d_{11}t_{13} + d_{13}t_{33} \\ d_{31}t_{11} + d_{33}t_{31} & d_{31}t_{13} + d_{33}t_{33} \end{pmatrix} + d^{2} \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij} \int \frac{d^{2}q}{(2\pi)^{2}} g_{ij}(|\mathbf{k} - \mathbf{q}|)$$

$$\times \begin{pmatrix} K_{11}^{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{q} | \omega) & K_{13}^{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{q} | \omega) \\ K_{31}^{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{q} | \omega) & K_{33}^{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{q} | \omega) \end{pmatrix} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{1}(\mathbf{k} | \omega) \\ F_{3}(\mathbf{k} | \omega) \end{pmatrix}, \quad (25)$$
The $K_{a\mu}^{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{q} | \omega) = d_{\alpha\beta}(k | \omega) T_{\beta\delta}^{(i)}(\mathbf{k}, \mathbf{q} | \omega) d_{\delta\alpha}(q | \omega)$

 $\times T^{(j)T}_{\alpha\mu}(\mathbf{k},\mathbf{q}\,|\,\omega).$

Уравнение (24) описывает преимущественно волны горизонтальной поляризации, а (25) — сагиттальной. Функция Грина для Z-среза полубесконечного гексагонального кристалла со свободной границей получена в [25] для любых значений x_3, x'_3 . В нашем случае $x_3 = 0$; $x'_3 = 0$, в результате чего функция Грина существенно упрощается.

4. Дисперсионное соотношение для ПАВ Рэлея

Будем искать дисперсионное соотношение для волн сагиттальной поляризации. Заметим, что условие разрешимости (25), дающее дисперсионное соотношение, можно записать в виде

$$\det(1+\delta A)=0.$$
 (26)

Для любых квадратных матриц 2×2

$$\det(A + \delta A) = \det A + \det A \cdot \operatorname{Sp}((A^{-1})^T \delta A) + \det \delta A.$$
(27)

Из (27) и (26) следует выражение

$$1 = -\operatorname{Sp}(\delta A) + \det \delta A. \tag{28}$$

При рассмотрении (25) и (28) видно, что есть компоненты функции Грина $d_{\alpha\beta}(k \mid \omega)$, знаменатель которых может обращать правую часть (28) в бесконечность при некоторых значениях переменной *k*. Умножив (28) на этот знаменатель, получим

$$A(k \mid \omega) = Z(k \mid \omega), \tag{29}$$

где $A(k \mid \omega)$ приведено в Приложении.

При d = 0 выражение $Z(k \mid \omega)$ обращается в нуль, и уравнение

$$A(k \mid \omega) = 0 \tag{30}$$

дает известное дисперсионное соотношение для Z-среза гексагонального кристалла на свободной плоской поверхности [25]. Решение (30) имеет вид

$$\rho\omega_R^2 = c_{44}\varepsilon k^2,\tag{31}$$

где є зависит только от компонент тензора модулей упругости.

Разлагая далее в (29) $A(k \mid \omega)$ в ряд Тейлора по ω в окрестности $\omega = \omega_R$, запишем закон дисперсии в виде

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_R} = \frac{\omega - \omega_R}{\omega_R} = \frac{1}{\omega_R \left(\frac{\partial A(k \mid \omega_R)}{\partial \omega}\right)} Z(k \mid \omega) \Big|_{\omega \to \omega_R + i\alpha}, \quad (32)$$

где *а* — малое вещественное число, а

$$Z(k \mid \omega) = A(k \mid \omega)(d_{11}t_{11} + d_{13}t_{31} + d_{31}t_{13} + d_{33}t_{33})$$

- $A(k \mid \omega) \det \delta A + A(k \mid \omega)d^2 \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}$
 $\times \int \frac{d^2q}{(2\pi)^2} g_{ij}(|\mathbf{k} - \mathbf{q}|) (K_{11}^{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{q} \mid \omega) + K_{33}^{ij}(\mathbf{k}, \mathbf{q} \mid \omega)).$
(33)

В $Z(k \mid \omega)$ оставляем только члены, пропорциональные до d^2 . Введем переменные

$$\xi_{ij} = k a_{ij}, \quad \eta = \frac{q}{k} \tag{34}$$

и проинтегрируем по углам, используя интегральное представление модифицированной функции Бесселя. В (33) часть подынтегрального выражения содержит в знаменателе $A(q, \omega_R + i\alpha)$, для которого можно записать

$$\frac{1}{A(q, \omega_R + i\alpha)} = P \frac{1}{A(q, \omega_R)}$$
$$- i\pi \operatorname{Sign}\left(\frac{\frac{\partial A(k, \omega_R)}{\partial \omega}}{\frac{\partial A(k, \omega_R)}{\partial q}}\right) \frac{\delta(\eta - 1)}{k \frac{\partial A(k, \omega_R)}{\partial q}}, \quad (35)$$

где символ P означает интегрирование в смысле главного значения Коши, а Sign(x) — знак x.

В результате получаем дисперсионное соотношение

$$\frac{\Delta\omega(k)}{\omega_R} = \gamma \left[kd\chi + (kd)^2 \psi + (kd)^2 \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^3 \varepsilon_{ij} \xi_{ij}^2 \right] \\ \times \exp(-\xi_{ij}^2/4) \left(A^{ij}(\xi_{ij}) + B^{ij}(\xi_{ij}) + E^{ij}(\xi_{ij}) \right) \right].$$
(36)

Здесь

$$A^{ij}(\xi_{ij}) = \int_{0}^{\infty} d\eta \,\eta \, \frac{\exp(-\xi_{ij}^{2}\eta^{2}/4)}{\alpha_{tt}(\eta)} \sum_{m=\theta}^{4} P_{m}^{ij}(\eta) I_{m}(\eta\xi_{ij}^{2}/2),$$
(37)

$$B^{ij}(\xi_{ij}) = P \int_{0}^{\infty} d\eta \,\eta \, \frac{\exp(-\xi_{ij}^{2}\eta^{2}/4)}{\tilde{A}(\eta)} \sum_{m=0}^{4} Q_{m}^{ij}(\eta) I_{m}(\eta\xi_{ij}^{2}/2),$$
(38)

символ *P* означает интегрирование в смысле главного значения Коши, полюс находится в точке $\eta_0 = 1$, а его значение $E^{ij}(\xi_{ij})$ приведено в Приложении; $I_m(z)$ — модифицированные функции Бесселя,

$$I_m(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \exp(z \cos \theta) \cos m\theta,$$

 χ, ψ, γ — константы, зависящие от характеристик гексагонального кристалла и изотропного слоя.

Остальные величины приведены в Приложении. Матрицы P_m^{ij} и Q_m^{ij} симметричны относительно перестановки верхних индексов.

Комплексный сдвиг частоты делится на вещественную и мнимую части

$$\Delta\omega(k) = \nu_1(k) - i\nu_2(k). \tag{39}$$

При этом $\nu_1(k)$ дает дисперсию фазовой скорости волны Рэлея, а мнимая часть $\nu_2(k)$ — обратную длину затухания

$$\frac{1}{l(k)} = 2k \frac{\nu_2(k)}{\omega_R}.$$
(40)

Если в задаче о распространении ПАВ по структурнонарушенному слою положить параметры слоя постоянными величинами, то получится задача о распространении ПАВ в системе "однородный слой на полупространстве". Рассмотрение такого частного случая дает возможность частично проверить полученные результаты. В частности, в работе [26] найдена дисперсия фазовой скорости для тонкого гексагонального слоя, лежащего на гексагональной полубесконечной подложке, в первом порядке по *d*. В [27] рассмотрена задача о распространении ПАВ в системе, состоящей из нескольких различных изотропных слоев (суммарная толщина которых мала по сравнению с длиной волны), лежащих на изотропной подложке. При сравнении результатов настоящей работы с результатами [26,27] показано их совпадение.

5. Длинноволновой предел

В длинноволновом пределе длина рэлеевской волны λ велика по сравнению со всеми корреляционными радиусами неоднородности a_{ij} .

Рассмотрим вещественную часть (36). Интегралы (37), (38) "набирают" свое основное значение при $\xi_{ij}\eta = ka_{ij}\eta \approx 1$; следовательно, $\eta \gg 1$. Аргумент модифицированных функций Бесселя мал, поэтому

$$I_m(z) \approx \frac{1}{m!} \left(\frac{z}{2}\right)^m \left(1 + O(z)\right). \tag{41}$$

Мнимая часть интегралов равна нулю при $\eta > \sqrt{\varepsilon/h} \approx 1$ для (37) и $\eta > \sqrt{\varepsilon} \approx 1$ для (38), поэтому для



Графики безразмерных функций *v_{ij}*, характеризующих обратную длину затухания рэлеевских волн в структуре гексагональная подложка ZnO–изотропный слой ZnO.

вычисления мнимой части нужно под интегралами (37), (38) положить $\xi_{ij}\eta = 0$. В результате получаем

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_R} = \gamma Z, \tag{42}$$

$$\operatorname{Re}(Z) = -kdc_{33}(\alpha_{11} + \alpha_{22}) \left(\frac{\rho_0}{\rho} c_{44}\varepsilon - b_0 - 2\mu_0 - \frac{c_{44}\varepsilon - c_{11}}{\alpha_{11}\alpha_{22}c_{33}} \frac{\rho_0}{\rho} c_{44}\varepsilon \right) + \frac{kd}{2} \left(\varepsilon_{33} \frac{d}{a_{33}} \frac{\sqrt{\pi}\mu_0^2 c_{33}}{c_{44}\sqrt{h}} \times (\alpha_{11} + \alpha_{22}) - \sum_{i,j=2}^3 \varepsilon_{ij} \frac{d}{a_{ij}} \frac{2\sqrt{\pi}Q_{ij}}{a_{1}c_{33}c_{44}} \right),$$
(43)

$$\operatorname{Im}(Z) = \frac{k^4 d^2}{2} \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij} a_{ij}^2 \left(\int_{0}^{\sqrt{\frac{k}{h}}} d\eta \,\eta \, \frac{P_0^{ij}(\eta)}{\sqrt{\varepsilon - h\eta^2}} \right. \\ \left. + \operatorname{Im}\left(\int_{0}^{\sqrt{\varepsilon}} d\eta \,\eta \, \frac{Q_0^{ij}(\eta)}{\tilde{A}(\eta)} \right) + E^{ij}(0) \right), \qquad (44)$$

где величины Q_{ij} приведены в Приложении.

Отсюда следует, что изменение дисперсии фазовой скорости $v_1 \sim k^2 \sim \omega^2$, а обратная длина затухания $1/l \sim k^5 \sim \omega^5$.

6. Численный расчет

Дисперсионное соотношение (36) содержит 15 параметров, характеризующих поверхностный нарушенный слой. Это средние значения ρ_0 , λ_0 , μ_0 и по шесть независимых компонент ε_{ij} и a_{ij} . Мнимую часть $\Delta \omega$ для волн Рэлея можно записать в виде

$$\operatorname{Im} \frac{\Delta \omega}{\omega_R} = -\sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij} \frac{d^2}{a_{ij}^2} \nu_{ij}(\xi_{ij}), \qquad (45)$$

где $v_{ij}(\xi_{ij})$ — безразмерные функции, симметричные по нижним индексам и зависящие только от трех величин, характеризующих слой ρ_0 , λ_0 , μ_0 , а $\xi_{ij} = ka_{ij}$ является параметром. В работе [28] предложен метод определения изотропных упругих постоянных поликристаллических систем, полученных из данных для монокристаллов. Взяв из [28] соответствующие параметры, можно построить графики функций $v_{ij}(\xi_{ij})$. На рисунке представлены графики $v_{ij}(\xi_{ij})$ для волн Рэлея в системе "подложка ZnO с изотропным слоем ZnO". Все представленные на рисунке графики качественно подобны друг другу и различаются в основном знаком и амплитудой.

В частном случае тонких пленок флуктуирует только плотность. В этом случае из всех ε_{ij} отличным от нуля остается только ε_{11} и обратная длина затухания будет определяться только одним графиком $\nu_{11}(\xi)$, представленным на рисунке.

Таким образом, по сравнению с (45) остаются всего два свободных (подгоночных) параметра, характеризующих распределение неоднородностей в нарушенном слое, а именно: корреляционный радиус a_{11} и средне-квадратичная флуктуация плотности $\langle (\rho^{1,f}(\mathbf{x}_{\parallel}))^2 \rangle^{1/2}$.

7. Заключение

В работе впервые исследовано распространение рэлеевских волн вдоль свободной поверхности (гексагонального) кристалла с учетом структурно-нарушенного поверхностного слоя. Поверхностный слой предполагался изотропным и тонким по сравнению с длиной рэлеевской воны. В задаче рассматривалась флуктуация характеристик нарушенного слоя — плотности и коэффициентов Ламэ, произвольно зависящих от пространственных координат. Статистическое распределение флуктуаций неоднородностей нарушенного слоя предполагалось гауссовым. С помощью модифицированного метода среднего поля [7] в аналитическом виде получены дисперсия фазовой скорости и обратная длина затухания во втором порядке по толщине слоя.

В длинноволновом пределе, когда длина волны много больше корреляционных радиусов неоднородностей структурно-нарушенного слоя, показано, что дисперсия фазовой скорости пропорциональна второй степени частоты волны, а обратная длина затухания — пятой.

Для конкретного случая гексагональной подложки ZnO с учетом изотропного поверхностного слоя ZnO обратная длина затухания рэлеевской волны исследована численно.

Поскольку найденное в работе дисперсионное соотношение содержит 15 параметров, характеризующих поверхностный нарушенный слой, обсуждается частный случай тонких пленок, когда остаются всего два параметра, характеризующих распределение неоднородностей в слое. Заметим, что такая упрощенная модель может оказаться весьма полезной при исследовании параметров неоднородностей аморфных пленок.

Приложение

$$\begin{aligned} A_{\alpha\mu}(\mathbf{k} \mid \omega) &= -d\rho_0 \omega^2 \delta_{\alpha\mu} - d\left((b_0 + \mu_0)k_{\alpha}k_{\mu} + \mu_0 k^2 (\delta_{\alpha\mu} - \delta_{\alpha3}\delta_{\mu3})\right) - i \frac{d^2}{2} \left(-\rho_0 \omega^2 b_1 + k^2 (b_0 + 2\mu_0)\right) \\ &\times (\delta_{\alpha3}k_{\mu} - \delta_{\mu3}k_{\alpha}); \end{aligned} \tag{\Pi1}$$

$$B_{\beta\delta\alpha\mu}(\mathbf{q}, \mathbf{k}, \mathbf{k} - \mathbf{q} | \omega) = \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij} g_{ij}(|\mathbf{k} - \mathbf{q}|)$$
$$\times N_{\beta\delta}^{(i)}(\mathbf{k}, \mathbf{q} | \omega) N_{au}^{(j)T}(\mathbf{k}, \mathbf{q} | \omega); \tag{\Pi2}$$

$$egin{aligned} &N^{(1)}_{eta\delta}(\mathbf{k},\mathbf{q}\,|\,\omega)=-
ho_0\omega^2\delta_{eta\delta},\ &N^{(2)}_{eta\delta}(\mathbf{k},\mathbf{q}\,|\,\omega)=d_1k_eta q_\delta, \end{aligned}$$

$$N_{\beta\delta}^{(3)}(\mathbf{k},\mathbf{q} \mid \omega) = d_2 k_\beta q_\delta + \mu_0 \big(q_\beta k_\delta + (\mathbf{k},\mathbf{q}) (\delta_{\beta\delta} - \delta_{\beta3} \delta_{\delta3}) \big);$$
(II3)

$$b_{1} = \frac{d_{0}}{\lambda_{0}} + \left(\frac{d_{0}^{3}}{\lambda_{0}^{2}\mu_{0}} + \frac{d_{0}^{2}}{2\lambda_{0}\mu_{0}}\right)\varepsilon_{23} + \frac{d_{0}^{3}}{4\lambda_{0}\mu_{0}^{2}}\varepsilon_{22} + \frac{d_{5}}{\lambda_{0}}\varepsilon_{33} - \frac{d_{0}^{2}}{2\lambda_{0}\mu_{0}}\varepsilon_{12} + \frac{d_{2}}{\lambda_{0}}\varepsilon_{13}; \qquad (\Pi4)$$

$$b_0 = d_0 + d_3 \varepsilon_{23} + d_4 \varepsilon_{22} + d_5 \varepsilon_{33}; \tag{\Pi5}$$

$$d_0 = \frac{2\lambda_0\mu_0}{\lambda_0 + 2\mu_0}, \quad d_1 = d_0 - \frac{d_0^2}{2\mu_0}, \quad d_2 = d_0 - \frac{d_0^2}{\lambda_0}; \quad (\Pi 6)$$

Физика твердого тела, 2008, том 50, вып. 4

$$d_{3} = d_{0} - \frac{d_{0}^{2}}{\lambda_{0}} - \frac{d_{0}^{2}}{2\mu_{0}} + \frac{d_{0}^{3}}{\lambda_{0}\mu_{0}}, \quad d_{4} = \frac{d_{0}^{3}}{4\mu_{0}^{2}} - \frac{d_{0}^{2}}{2\mu_{0}},$$
$$d_{5} = \frac{d_{0}^{3}}{\lambda_{0}^{2}} - \frac{d_{0}^{2}}{\lambda_{0}}; \tag{II7}$$

 $E^{ij}(\xi_{ij}) = -i\pi$ Sign

$$\times \left(\frac{(1-\varepsilon)\left(2\frac{c_{33}}{c_{11}}\alpha_{11}\alpha_{22}+2-3\frac{c_{44}}{c_{11}}\varepsilon\right)+\varepsilon\left(1-\frac{c_{44}}{c_{11}}\varepsilon\right)}{(1-\varepsilon)\left(2a_{1}\frac{c_{33}}{c_{11}}\alpha_{11}\alpha_{22}-\varepsilon\right)+\varepsilon\left(1-\frac{c_{44}}{c_{11}}\varepsilon\right)}\right) \\\times \frac{\alpha_{11}\alpha_{22}(1-\varepsilon)\exp(-\xi_{ij}^{2}/4)}{c_{11}c_{44}\left((1-\varepsilon)\left(2a_{1}\frac{c_{33}}{c_{11}}\alpha_{11}\alpha_{22}-\varepsilon\right)+\varepsilon\left(1-\frac{c_{44}}{c_{11}}\varepsilon\right)\right)} \\\times \sum_{m=0}^{4}Q_{m}^{ij}(1)I_{m}(\xi_{ij}^{2}/2); \tag{I18}$$

$$\gamma = \frac{\alpha_{11}\alpha_{22}(1-\varepsilon)}{c_{11}c_{44}\varepsilon((1-\varepsilon)(2\frac{c_{33}}{c_{11}}\alpha_{11}\alpha_{22}+2-3\frac{c_{44}}{c_{11}}\varepsilon)+\varepsilon(1-\frac{c_{44}}{c_{11}}\varepsilon))};$$
(II9)

$$\begin{split} \chi &= -c_{33}(\alpha_{11} + \alpha_{33}) \\ &\times \left(\frac{\rho_0}{\rho} c_{44}\varepsilon - b_0 - 2\mu_0 - \frac{c_{44}\varepsilon - c_{11}}{\alpha_{11}\alpha_{22}c_{33}} \frac{\rho_0}{\rho} c_{44}\varepsilon\right); \ (\Pi 10) \\ \psi &= \left(-c_{13} + \frac{c_{11} - c_{44}\varepsilon}{\alpha_{11}\alpha_{22}}\right) \left(-\frac{\rho_0}{\rho} c_{44}\varepsilon b_1 + b_0 + 2\mu_0\right) \\ &+ \frac{\rho_0}{\rho} c_{44} \left(\frac{\rho_0}{\rho} c_{44}\varepsilon + b_0 + 2\mu_0\right) \left(1 + \frac{c_{33}}{c_{44}} (a_1 - \varepsilon)\right); \\ (\Pi 11) \end{split}$$

$$A(\eta) = c_{13}^2 \eta^2 + (c_{11}\eta^2 - c_{44}\varepsilon) \left(\frac{c_{44}\varepsilon}{\tilde{\alpha}_{11}\tilde{\alpha}_{22}} - c_{33}\right); \quad (\Pi 12)$$

$$\alpha_{tt}(\eta) = \begin{cases} \sqrt{\eta^2 h - \varepsilon}, & \eta^2 h - \varepsilon \ge 0, \\ -i\sqrt{\varepsilon - \eta^2 h}, & \eta^2 h - \varepsilon < 0; \end{cases}$$
(II13)

$$h = \frac{c_{11} - c_{12}}{2c_{44}};\tag{\Pi14}$$

$$\begin{split} \tilde{\alpha}_{11}^2 &= \frac{1}{2} \left(x + \sqrt{x^2 - 4y^2} \right), \quad \text{Re} \, \tilde{\alpha}_{11,22}^2 > 0, \\ \tilde{\alpha}_{22}^2 &= \frac{1}{2} \left(x - \sqrt{x^2 - 4y^2} \right), \quad \text{Im} \, \tilde{\alpha}_{11,22}^2 < 0, \\ x &= \left(a_1 + 2 \frac{c_{13}}{c_{33}} \eta^2 \right) - \frac{c_{33} + c_{44}}{c_{33}} \varepsilon, \\ y^2 &= \frac{1}{c_{33}} \left(\eta^2 - \varepsilon \right) (c_{11} \eta^2 - c_{44} \varepsilon); \end{split}$$
(II15)

$$\alpha_{11,22} = \tilde{\alpha}_{11,22} \big|_{\eta=1};$$
 (II16)

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{c_{44}}{c_{33}}\right)\varepsilon^3 + \left(\frac{c_{11}}{c_{33}} - 1 - 2a_1\right)\varepsilon^2 \\ + a_1(2 + a_1)\varepsilon - a_1^2 = \mathbf{0}, \\ \mathbf{0} < \varepsilon < \min(1, a_1), \quad a_1 = \frac{c_{11}c_{33} - c_{13}^2}{c_{33}c_{44}}; \end{cases}$$
(II17)

$$P_0^{11} = -P_2^{11} = \left(\frac{\rho_0}{\rho}\right)^2 \frac{c_{44}\varepsilon^2 c_{33}}{2} \left(\alpha_{11} + \alpha_{22}\right); \quad (\Pi 18)$$

$$P_1^{13} = -P_3^{13} = -\left(\frac{\rho_0}{\rho}\right) \frac{\varepsilon \eta \mu_0 c_{33}}{2} \left(\alpha_{11} + \alpha_{22}\right); \quad (\Pi 19)$$

$$P_0^{33} = -P_4^{33} = \eta^2 \frac{\mu_0^2 c_{33}}{2c_{44}} \left(\alpha_{11} + \alpha_{22} \right); \tag{II20}$$

$$Q_0^{11} = \left(\frac{\rho_0}{\rho}\right)^2 (c_{44}\varepsilon)^2 \left(\frac{1}{2}c_{33}(\alpha_{11} + \alpha_{22})c_{33}(\tilde{\alpha}_{11} + \tilde{\alpha}_{22})\right)$$

$$+\frac{(c_{44}\varepsilon-c_{11})(\alpha_{11}+\alpha_{22})}{\alpha_{11}\alpha_{22}}\frac{(c_{44}\varepsilon-c_{11}\eta^2)(\tilde{\alpha}_{11}+\tilde{\alpha}_{22})}{\tilde{\alpha}_{11}\tilde{\alpha}_{22}}\Big);$$
(II21)

$$Q_{1}^{11} = \left(\frac{\rho_{0}}{\rho}\right)^{2} (c_{44}\varepsilon)^{2} 2\left(-c_{13} + \frac{c_{11} - c_{44}\varepsilon}{\alpha_{11}\alpha_{22}}\right) \\ \times \left(-c_{13} + \frac{c_{11}\eta^{2} - c_{44}\varepsilon}{\tilde{\alpha}_{11}\tilde{\alpha}_{22}}\right); \tag{\Pi22}$$

$$Q_2^{11} = \left(\frac{\rho_0}{\rho}\right)^2 (c_{44}\varepsilon)^2 \frac{1}{2} c_{33}^2 (\alpha_{11} + \alpha_{22}) (\tilde{\alpha}_{11} + \tilde{\alpha}_{22}); \quad (\Pi 23)$$

$$Q_{0}^{12} = -\frac{\rho_{0}}{\rho} c_{44} \varepsilon \eta d_{1} \left(c_{13} + \frac{c_{44} \varepsilon - c_{11}}{\alpha_{11} \alpha_{22}} \right) \\ \times \left(c_{13} + \frac{c_{44} \varepsilon - c_{11} \eta^{2}}{\tilde{\alpha}_{11} \tilde{\alpha}_{22}} \right); \tag{\Pi24}$$

$$Q_1^{12} = -\frac{\rho_0}{\rho} c_{44} \varepsilon \eta d_1 c_{33}^2 (\alpha_{11} + \alpha_{22}) (\tilde{\alpha}_{11} + \tilde{\alpha}_{22}); \quad (\Pi 25)$$

$$Q_0^{13} = -\frac{\rho_0}{\rho} c_{44} \varepsilon \eta (d_2 + \mu_0) \left(c_{13} + \frac{c_{44} \varepsilon - c_{11}}{\alpha_{11} \alpha_{22}} \right) \times \left(c_{13} + \frac{c_{44} \varepsilon - c_{11} \eta^2}{\alpha_{11} \alpha_{22}} \right); \tag{II26}$$

$$= -\frac{\rho_0}{\alpha} c_{44} \varepsilon \eta c_{33}^2 (\alpha_{11} + \alpha_{22}) (\tilde{\alpha}_{11} + \tilde{\alpha}_{22}) \left(d_2 + \mu_0 \frac{3}{2} \right);$$

$$\times \left(c_{13} + \frac{c_{44}\varepsilon - c_{11}\eta^2}{\tilde{\alpha}_{11}\tilde{\alpha}_{22}}\right); \tag{\Pi28}$$

$$Q_3^{13} = -\frac{\rho_0}{\rho} c_{44} \varepsilon_\eta \frac{\mu_0}{2} c_{33}^2 (\alpha_{11} + \alpha_{22}) (\tilde{\alpha}_{11} + \tilde{\alpha}_{22}); \quad (\Pi 29)$$

$$Q_{0}^{22} = d_{1}^{2} \eta^{2} c_{33}^{2} (\alpha_{11} + \alpha_{22}) (\tilde{\alpha}_{11} + \tilde{\alpha}_{22}); \qquad (\Pi 30)$$

$$Q_{0}^{23} = d_{1} (d_{2} + u_{2}) \eta^{2} c_{2}^{2} (\alpha_{22} + \alpha_{22}) (\tilde{\alpha}_{22} + \tilde{\alpha}_{22}); \qquad (\Pi 31)$$

$$Q_0 = a_1(a_2 + \mu_0)\eta \ c_{33}(a_{11} + a_{22})(a_{11} + a_{22}); \quad (\Pi 31)$$
$$Q_2^{23} = \mu_0 d_1 \eta^2 c_{33}^2(a_{11} + a_{22})(\tilde{a}_{11} + \tilde{a}_{22}); \quad (\Pi 32)$$

$$Q_0^{33} = \eta^2 c_{33}^2 \left(d_2^2 + 2\mu_0 d_2 + \frac{3}{2} \mu_0^2 \right) (\alpha_{11} + \alpha_{22}) (\tilde{\alpha}_{11} + \tilde{\alpha}_{22});$$
(II33)

$$Q_2^{33} = 2\eta^2 c_{33}^2 \mu_0 (d_2 + \mu_0) (\alpha_{11} + \alpha_{22}) (\tilde{\alpha}_{11} + \tilde{\alpha}_{22}); \quad (\Pi 34)$$

$$Q_4^{33} = \eta^2 \frac{\mu_0^2}{2} c_{33}^2 (\alpha_{11} + \alpha_{22}) (\tilde{\alpha}_{11} + \tilde{\alpha}_{22}); \qquad (\Pi 35)$$

$$Q_m^{ij} = Q_m^{ij}, \quad P_m^{ij} = P_m^{ji}.$$
 (II36)

Остальные элементы P_m^{ij} и Q_m^{ij} равны нулю.

$$Q_{22} = d_1^2 c_{33}^2 (\alpha_{11} + \alpha_{22}) \left(\sqrt{a_2 + b_2} + \sqrt{a_2 - b_2} \right); \quad (\Pi 37)$$
$$Q_{33} = \left(d_2^2 + 2\mu_0 d_2 + \frac{3}{2} \mu_0^2 \right) c_{33}^2 (\alpha_{11} + \alpha_{22})$$
$$\times \left(\sqrt{a_2 + b_2} + \sqrt{a_2 - b_2} \right); \quad (\Pi 38)$$

$$Q_{23} = Q_{32} = d_1(d_2 + \mu_0)c_{33}^2(\alpha_{11} + \alpha_{22})$$

$$\times \left(\sqrt{a_2 + b_2} + \sqrt{a_2 - b_2}\right); \tag{II39}$$

$$a_2 = \frac{a_1}{2} - \frac{c_{13}}{c_{33}}, \quad b_2 = \sqrt{a_2^2 - \frac{c_{11}}{c_{33}}}.$$
 (II40)

Список литературы

- [1] Е.И. Уразаков, Л.А. Фальковский. ЖЭТФ 63, 2297 (1972).
- [2] В.В. Крылов. В.Е. Лямов. ЖТФ 49, 2514 (1979).
- [3] Ф.Г. Басс, И.М. Фукс. Рассеяние волн на статистически неровной поверхности. Наука, М. (1972). 424 с.
- [4] A.G. Eguiluz, A.A. Maradudin. Phys. Rev. B 28, 728 (1983).
- [5] Ю.В. Гуляев, М.А. Магомедов, Р.П. Мейланов. РЭ 6, 1091 (1985).
- [6] В.В. Косачёв, Ю.Н. Лохов, В.Н. Чуков. ЖЭТФ 94, 162 (1988).
- [7] V.V. Kosachev, A.V. Shchegrov. Ann. Phys. (N.Y.) 240, 225 (1995).
- [8] C. Minton. Nondest. Test 12, 13 (1954).
- [9] В.А. Ломакин. Теория упругости неоднородных тел. МГУ, М. (1976). 78 с.
- [10] В.П. Алёхин. Физика прочности и пластичности поверхности слоев материалов. Наука, М. (1983). 280 с.
- [11] Л.М. Бреховских. Волны в слоистых средах. Наука, М. (1973). 341 с.
- [12] И.А. Викторов. Звуковые поверхностные волны в твердых телах. Наука, М. (1981). 287 с.
- [13] A.D. Hyndman, S.B. Palmer. Ultrasonic **20**, 73 (1973).
- [14] J.M. Richardson. J. Appl. Phys. 48, 498 (1977).
- [15] J.M. Richardson, B.R. Tittmann. J. Appl. Phys. 48, 5111 (1977).
- [16] В.Н. Данилов, В.С. Лищиков. Акуст. журн. 31, 323 (1985).
- [17] С.Ж. Жарылкапов, В.В. Крылов. Акуст. журн. 33, 878 (1987).
- [18] В.Д. Харитонов. ФТТ 27, 553 (1985).
- [19] J.A. Bucaro, L. Flax. J. Appl. Phys. 45, 765 (1974).
- [20] И.А. Кайбичев. Акуст. журн. 32, 688 (1986).
- [21] А.Г. Аленицын. ПММ 37, 895 (1973).
- [22] В.Н. Чуков. ФТТ 39, 267 (1997).
- [23] Masa-aki Narita, Tetsuro Sakuma, Tsuneyoshi Nakayama. J. Appl. Phys. 49, 5507 (1978).
- [24] V.V. Kosachev. Proc. IV Int. Symp. on surface waves in solid and layered structures. St. Petersburg (1998). P. 107.
- [25] L. Dobrzynski, A.A. Maradudin. Phys. Rev. B 14, 2200 (1976); Erratum. Phys. Rev. B 15, 2432 (1977).
- [26] V.R. Velasco, O. Hardouin Duparc, B. Djafari-Rouhani. Surf. Sci. 114, 574 (1982).
- [27] V.V. Kosachev, A.V. Shchegrov. Solid State Commun. 93, 701 (1995).
- [28] O.L. Anderson. Phys. Acoust. B 3, 80 (1965).

 Q_1^{13}